

PAH350S24 - *

RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG.No. C175-57-01/350A			
承認	承認	査閲	担当
Takahashi 19. Dec. '03	Tomidaka 19. Dec. '03	Kawagoe 18. Dec. '03	Y. Hiyama 18. Dec. '03

I N D E X

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2. 部品ディレーティング Component Derating	R-2
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-4
4. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-5
5. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test	R-9

※ 振動試験、ノイズシミュレート試験、はんだ耐熱性試験、高温貯蔵試験、低温貯蔵試験、高温加湿通電試験におきましては PAH300S24-* とほぼ同等の特性を示し、信頼性に変化はありません。詳細につきましては PAH300S24-* 信頼性データをご参照下さい。

Regarding Vibration Test , Noise Shimulate Test , Resistance to Soldering Heat Test , High Temperature Storage Test , Low Temperature Storage Test and High Temperature and High Humidity Bias Test , result shows equivalent characteristic to PAH300S24-* and reliability does not have change.
For details, please refer to PAH300S24-* RELIABILITY DATA.

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The following data are typical values. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability values.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PAH350S24-28

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{SS} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{SS} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

*1: Telcordia (Bellcore) "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"
(Document number TR-332, Issue5)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{SSi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{SSi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the *i*th device

π_{Qi} : i番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the *i*th device

π_{Si} : i番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the *i*th device

π_{Ti} : i番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the *i*th device

m : 異なる部品の数 Number of different device types

N_i : i番目の部品の個数 Quantity of *i*th device type

π_E : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

(2) MTBF値 MTBF Values

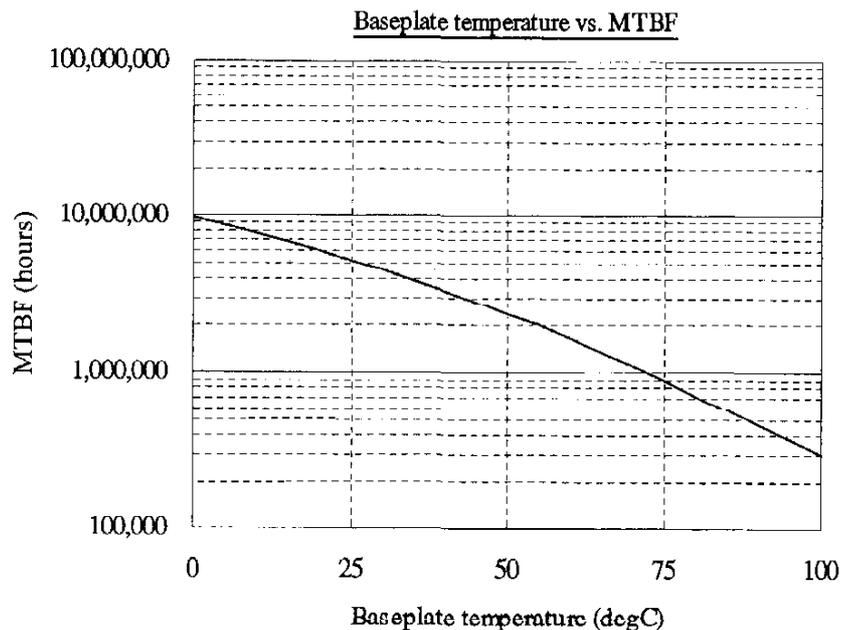
条件 Conditions : $V_{in} = 24VDC$

Environment GB (Ground, Benign)

PAH350S24-28

Output current: 12.5A (100%)

Baseplate temperature	MTBF
25°C	5,181,681 (hours)
50°C	2,383,142 (hours)
75°C	892,307 (hours)



2. 部品ディレーティング Component Derating

MODEL : PAH350S24-28

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定条件 Measuring Conditions

- ・入力電圧 : 24VDC
Input Voltage
- ・出力電流 : 12.5A (100%)
Output Current
- ・取付方法 : 標準取付
Mounting Method Standard Mounting Method
- ・ベースプレート温度 : 90℃
Baseplate Temperature

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

ベースプレート温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Baseplate temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-bp} = \frac{T_{j(max)} - T_{bp}}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25℃
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

T_{bp} : ディレーティングの始まるベースプレート温度 一般に25℃
Baseplate Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25℃
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$P_{c(max)}$: 最大コレクタ(チャネル)損失
($P_{ch(max)}$) Maximum Collector(Channel) Dissipation

$T_{j(max)}$: 最大接合点温度
($T_{cb(max)}$) Maximum Junction(Channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合部からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

θ_{j-bp} : 接合点からベースプレートまでの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and Baseplate

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
Thermal Impedance between Junction and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 102.40°C	68.3%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 102.89°C	68.6%	
Q3	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 105.17°C	70.1%	
Q102	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 113.21°C	75.5%	
Q202	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 103.45°C	69.0%	
D103	CHIP DIODE	T _j (max): 150.0°C	T _j : 100.20°C	66.8%	
D104	CHIP DIODE	T _j (max): 150.0°C	T _j : 100.90°C	67.3%	
A1	Pri PWM IC	T _j (max): 150.0°C	T _j : 110.48°C	73.7%	

3. 主要部品温度上昇値

Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : PAH350S24-28

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 $\Delta T_{C,P}$ Temperature Rise(°C)
Q3	CHIP MOS FET	14.6
Q102	CHIP MOS FET	17.2
L103	CHOKE COIL	6.2
T101	TRANS.,PULSE	22.2
D103	CHIP DIODE	1.8
D104	CHIP DIODE	0.2
	BASE-PLATE	0.0 (basis)

・ 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	標準取付 (放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)
	<p>$T_a = 25^\circ\text{C}$</p> <p>放熱器 Heatsink</p> <p>ベースプレート Base-Plate</p> <p>電源 Power Supply</p> <p>ベースプレート温度測定点 (90°C) Measuring point of Base-Plate Temperature</p> <p>入力側 Input</p> <p>出力側 Output</p> <p>21mm</p>
入力電圧 Input Voltage	24VDC
出力電圧 Output Voltage	28VDC
出力電流 Output Current	PAH350S24-28 : 12.5A (100%)

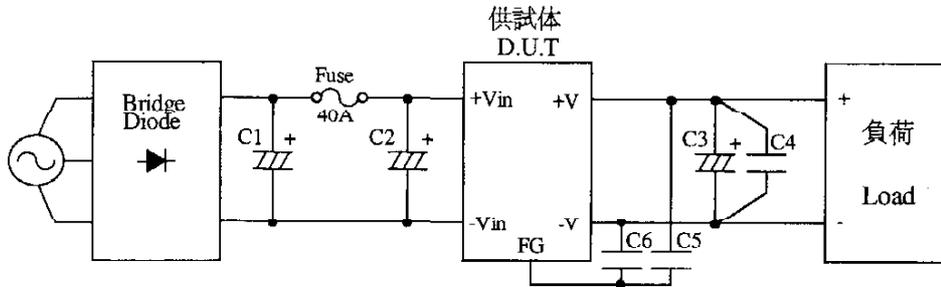
$\Delta T_{C,P}$: 周囲温度 25°C においてベースプレート温度が 90°C となる放熱器を装着し、その時のベースプレート温度を基準とした各部品の ΔT (ベースプレートと部品との温度差)を表したもの。

Temperature difference between a case of each component and base-plate, fitted power supply with heatsink to be maintained 90°C (base-plate temperature) at 25°C (ambient temperature).

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PAH350S24-28

(1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit



- ・ 入力電圧 : 36VDC
- ・ 出力電流 : 12.5A(100%)
- Input Voltage
- Output Current
- ・ ベースプレート温度 : 25°C
- ・ 使用ヒューズ : 40A
- Base-Plate Temperature
- Additional Fuse
- ・ブリッジダイオード (D) : PGH758A
- ・ 電解コンデンサ (C1) : 250V 15000 μF
- Bridge Rectifier
- Electrolytic Cap.
- ・ 電解コンデンサ (C2) : 50V 220 μF × 2para
- ・ 電解コンデンサ (C3) : 50V 220 μF
- Electrolytic Cap.
- Electrolytic Cap.
- ・ セラミックコンデンサ (C4) : 50V 0.1 μF
- ・ フィルムコンデンサ (C5,C6) : 250V 0.022 μF
- Ceramic Cap.
- Film Cap

(2) 試験結果 Test Results

No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note	
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Bu:Burst	Se:Smell	Re:Red Hot	Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	OV P	OC P	出力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot		
1	Q101	G		●						●	●			●			Da:Q101,Q102	
2		S		●						●	●			●			Da:Q102	
3		D		●							●	●			●		Da:Q102	
4		D-S	●									●			●			
5		G-S	●												●			
6		D-G	●								●	●			●			Da:R3,Q101

No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note	
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Ru:Burst	Se:Small	Re:Red Hot	Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot		
7	Q1	E		●														
8		C		●												●	効率低下 (Efficiency Down)	
9		B		●														
10		B-E	●															
11		C-E	●															
12		B-C	●															
13	Q2	E		●						●	●			●			Da:Q101,Q102	
14		C		●												●	効率低下 (Efficiency Down)	
15		B		●						●	●			●			Da:Q101,Q102	
16		B-E	●														●	効率低下 (Efficiency Down)
17		C-E	●												●			
18		B-C	●												●			
19	Q3	G		●										●				
20		S		●										●				
21		D		●										●				
22		D-S	●							●				●				Da:Q3,R30,R34
23		G-S	●											●				
24		D-G	●							●				●				Da: R30,R34
25	Q201	E		●											●			
26		C		●											●			
27		B		●											●			
28		B-E	●												●			
29		C-E	●												●			
30		B-C	●												●			
31	Q202	E		●								●		●				
32		C		●										●				
33		B		●								●		●				
34		B-E	●												●			
35		C-E	●							●							●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:A202,D205,Z204
36		B-C	●							●							●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:A202,Z204
37	Q203	E		●											●			
38		C		●											●			
39		B		●											●			
40		B-E	●												●			
41		C-E	●												●			
42		B-C	●												●			

No.	試験箇所 Test Position		試験 モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note	
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Bu:Burst	Se:Smell	Re:Red Hot									
					Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others	1	2	3	4	5	6	7		8
					発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot		
43	Q204	E		●								●		●				
44		C		●								●		●				
45		B		●								●		●				
46		B-E	●												●			
47		C-E	●											●				
48		B-C	●											●				
49	D101			●											●			
50				●										●				
51	D103			●						●						●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:D201,D204	
52				●												●	出力電圧低下 (Output Voltage Down)	
53	D104			●												●	効率低下 (Efficiency Down)	
54				●									●					
55	D1			●														
56				●													●	出力電圧低下 (Output Voltage Down)
57	D2			●												●		
58				●												●		
59	D3			●										●				
60				●												●		
61	D4			●										●				
62				●										●				
63	D5			●										●				
64				●												●		
65	D6			●												●		
66				●												●		
67	D7			●												●		
68				●												●		
69	D201			●												●		
70				●												●		
71	D202			●												●		
72				●												●		
73	D203			●												●		
74				●									●					
75	D204			●												●		
76				●												●		
77	D205			●												●		
78				●												●		
79	Z1			●												●		
80				●										●				

試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note
部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Bu:Burst	Se:Smell	Re:Red Hot	Du:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others			
				1 発 火 Fi	2 発 煙 So	3 破 裂 Bu	4 異 臭 Se	5 発 熱 Re	6 破 損 Da	7 ヒ ュー ズ 断 Fu	8 O V P	9 O C P	10 出 力 断 NO	11 変 化 な し NC	12 そ の 他 Ot	
81	Z201		●													
82	Z201	●											●			
83	Z202		●													
84	Z202	●														
85	Z204		●													
86	Z204	●											●			
87	C101		●													
88	C101	●								●			●			
89	C103		●													
90	C103	●								●			●			
91	C108		●													
92	C108	●														
93	L101		●													
94	L101	●														
95	L103		●													
96	L103	●														● 出力電圧低下 (Output Voltage Down)
97	L1		●													
98	L1	●														
99	T101	1,2	●													
100	T101	3,4	●							●						● 出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:D201,D204
101	T101	1-3	●													● 効率低下 (Efficiency down)
102	T101	1-4	●													● 出力電圧低下 (Output Voltage Down)
103	T101	2-3	●													● 効率低下 (Efficiency down)
104	T101	2-4	●													● 出力電圧低下 (Output Voltage Down)
105	T102	2,3		●												●
106	T102	7,8		●												●
107	T102	2-3	●													●
108	T102	7-8	●													●
109	T102	2-7	●													●
110	T102	2-8	●													●
111	T102	3-7	●													●
112	T102	3-8	●													●
113	入力逆接続 Inverse Input Connection										●					

5. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PAH350S24-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

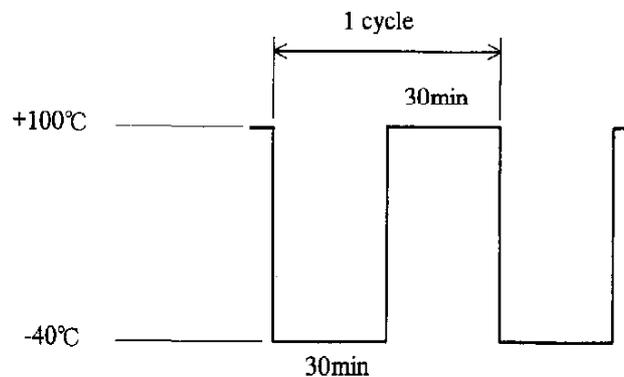
THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

3 台 (units)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・ 電源周囲温度 : -40℃ \longleftrightarrow +100℃
Ambient Temperature
- ・ 試験時間 : 30min \longleftrightarrow 30min
Test Time



- ・ 試験サイクル : 100、200 サイクル
Test Cycles 100, 200 cycles
- ・ 非動作
Not Operating

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100、200 サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. After the test is completed leave it for 1 hour at room temperature and check it if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは、次頁に示す。
See next page for measuring data.

